

業界首款 DFN3.3×3.3 封裝、RDS(on) 低於 1mΩ 的 30V N 通道 MOSFET

美國加州聖荷西，2025 年 12 月 1 日 - Analog Power 今日正式推出 AMS406N，一款超低導通電阻 0.99mΩ、額定 30V 的 N 通道 MOSFET，在小尺寸功率元件領域樹立了全新標竿。

AMS406N 的突破性之處在於：在標準 DFN3.3×3.3 封裝中實現了低於 1mΩ 的 RDS(on)。此前，此性能等級通常只能透過更大尺寸或特殊封裝形式才能達到。相較之下，AMS406N 在保持常規封裝尺寸的同時，實現了卓越的導通性能，為功率密度和設計靈活性帶來了全新可能。

透過在「常規」的 3.3mm × 3.3mm 封裝內實現 <1mΩ 的導通電阻，AMS406N 可顯著降低導通損耗，同時無需犧牲 PCB 面積、散熱能力或佈局自由度。這項優勢在目前產業解決方案多依賴新型、非標準封裝才能達到相近效能的背景下尤為突出。

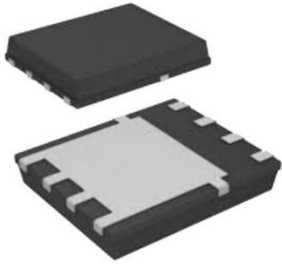
產品主要特性:

- 超低 RDS(on) = 0.99mΩ
- 30V N 通道溝槽型 MOSFET
- 快速開關特性
- 低熱阻設計
- DFN3.3×3.3 封裝，搭配裸露散熱焊盤，散熱性能優異

典型應用:

- 白光 LED 升壓轉換器
- 工業級 DC/DC 電源轉換電路
 - 大電流應用中的同步整流
- 高效率功率開關
- 高功率密度、熱優化的電源模組

- 無人機用 BLDC 無刷馬達驅動



Analog Power 的 AMS406N (0.99mΩ、30V N 通道 MOSFET, DFN3.3×3.3 封裝) 現已開放樣品申請, 並支援量產供貨。

產品初版數據手冊可訪問:

<https://www.analogpowerinc.com/products/AMS406N>.

如需了解更多信息, 請訪問: www.analogpowerinc.com.



關於 Analog Power

全新 0.99mΩ / 30V MOSFET 正式發布

Analog Power Inc.

Analog Power 成立於 2002 年，總部位於美國加州聖荷西，是一家專注於功率 MOSFET 的領先製造商。本公司產品涵蓋 20V 至 1500V 的 N 通道與 P 通道 MOSFET，同時提供多種應用專用型 MOSFET，助力客戶實現更小體積、更高性能的終端產品。

Analog Power 採用一線晶圓代工廠，並結合專業的封裝與測試外包服務，在確保市場領先品質與可靠性的同時，始終保持靈活、高效、以客戶為中心的營運模式。

聯絡方式

Analog Power Inc

台北市內湖區洲子街 58 號 1 樓A7

郵編：114064

<https://www.analogpowerinc.com/contactus.html>